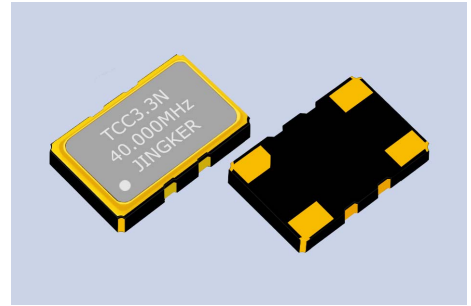


贴片封装 5.0×3.2mm 温补晶体振荡器



产品特点:

- 采用 AT 切片晶体, 频率稳定性高, 无倍频, 输出信号抖动低
- 启动速度快, 消耗电流低, 低老化率, 低相噪
- 军品级工作温度范围, 可靠性高, 抗震动能力强
- 符合 RoHS, 无铅指令产品

应用范围:

- 电脑周边产品, 电子通信设备, 测试设备, 仪器仪表
- 光传输设备, 通信基站, 北斗导航, 定位搜索, 电台发射接收
- 短波超短波微波通信, 集群通信, 抗干扰通信
- 广泛应用于国防军事装备领域, 高等级雷达航空航天卫星通信

技术规格:

| 项目 | 规格 | | | | 条件 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------------------------------------|
| | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 频率范围 | 6.000 | | 50.000 | MHz | |
| 标称频率 | | 10.000 | | MHz | 客户指定 |
| 初始频率准确度 | ±0.2 | | ±1.0 | ppm | |
| 温度频率稳定度 | ±0.1 | | ±2.0 | ppm | 请参照表 1 |
| 电源频率稳定度 | ±0.1 | | ±0.2 | ppm | 当工作电压变化±5%时 |
| 负载频率稳定度 | ±0.1 | | ±0.2 | ppm | 当输出负载变化±10%时 |
| 老化率 | | | ±1.0 | ppm | |
| 工作电压 | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V | 3.3V 可选 |
| 工作电流 | | | 1.5 | mA | Clipped Sinewave: 6.000~15.000MHz |
| | | | 2.0 | mA | Clipped Sinewave: 15.000~26.000MHz |
| | | | 2.5 | mA | Clipped Sinewave: 26.000~50.000MHz |
| | | | 10 | mA | CMOS,TTL: 6.000~50.000MHz |
| 输出波形 | Clipped Sinewave | | | | |
| 负载 | | 10/10 | | KΩ/pF | |
| 输出电平 | 1.0 | | | Vp-p | 工作电压=5.0V 时 |
| 输出波形 | CMOS,TTL | | | | |
| 负载 | | 15 | | pF | |
| 输出高电平 | 90% | | | Vcc | |
| 输出低电平 | | | 10% | Vcc | |
| 占空比 | 45 | | 55 | % | |
| 上升/下降时间 | | | 5 | ns | |
| 相位噪声 | | | -60 | dBc/Hz | @1Hz |
| | | | -90 | | @10Hz |
| | | | -120 | | @100Hz |
| | | | -140 | | @1KHz |
| | | | -150 | | @10KHz |
| | | | -155 | | @100KHz |
| 起振时间 | | | 10 | ms | 在+25°C |
| 压控电压 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | V | 电源电压=5.0V |
| | 0.3 | 1.65 | 3.0 | V | 电源电压=3.3V |
| 压控范围 | ±5.0 | | | ppm | |
| 线性度 | | | 10 | % | |
| 输入阻抗 | 100 | | | KΩ | |
| 工作温度范围 | -55 | | +85 | °C | 请参照表 1 |
| 储存温度范围 | -55 | | +125 | °C | |

贴片封装 5.0×3.2mm 温补晶体振荡器

温度频率稳定度(表 1):

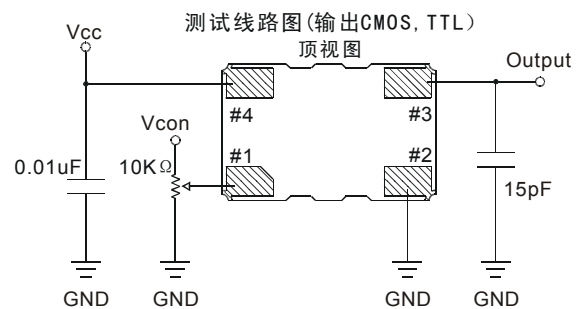
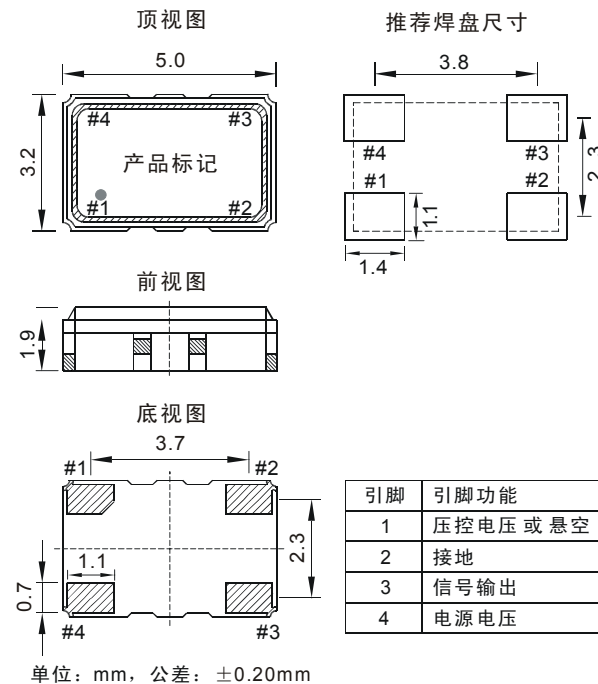
| 工作温度范围 | 频率稳定度(ppm)(Max) | | | | | |
|---------------|-----------------|------|------|------|------|------|
| | ±0.1 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.0 | ±2.0 | ±5.0 |
| B=-10°C~+60°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| C=-20°C~+70°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| D=-30°C~+75°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E=-40°C~+85°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| H=-55°C~+85°C | × | × | C | ✓ | ✓ | ✓ |

备注: ✓: 可选指标; ×: 不可选指标; C: 待确认指标。

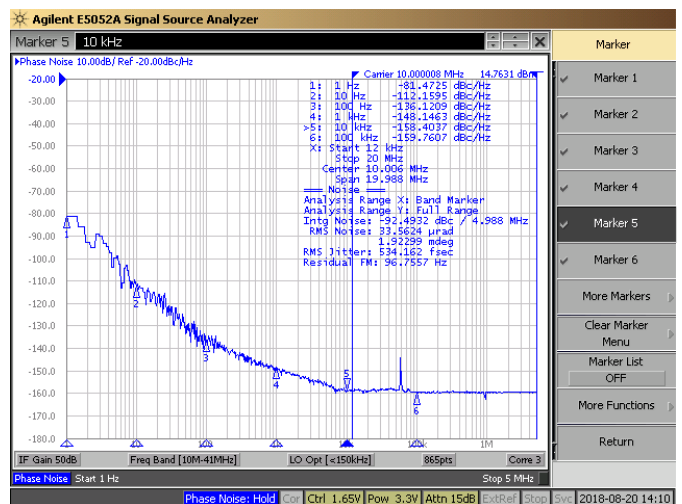
技术规范:

| | |
|------|------------------------------------|
| 总规范 | GJB 1648A-2011 |
| 质量等级 | 普军级(C级),军品级(B级) 七专级(Q级),宇航级(S级) |

封装尺寸:



温补晶体振荡器



如何确定型号:

示例型号: JTC-S23B-C16E3.3N-40.000MHz

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|--|--|--|-----------------|------------------------|---|-----------|
| JTC-S23B | - | C | 16 | E | 3.3 | N | - | 40.000MHz |
| 封装 | 输出波形 | 温度稳定度 | 工作温度范围 | 工作电压 | 压控特性 | 标称频率 | | |
| 贴片封装 5.0×3.2mm | T=CMOS,TTL C=Clipped Sine | 17=1×10 ⁻⁷ 27=2×10 ⁻⁷ 57=5×10 ⁻⁷ 16=1×10 ⁻⁶ 26=2×10 ⁻⁶ 56=5×10 ⁻⁶ | A=0°C~+50°C B=-10°C~+60°C C=-20°C~+70°C D=-30°C~+75°C E=-40°C~+85°C H=-55°C~+85°C | 5=5.0V 3.3=3.3V 2.5=2.5V 1.8=1.8V | Y=带压控 N=不带压控 | 6.000MHz~ 50.000MHz | | |